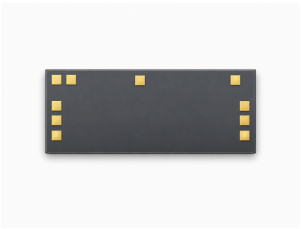
Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8000–12000 MHz

LCI-PA-8000-12000-PS39T-D es un amplificador de potencia GaN MMIC en formato de die sin encapsular para 8000–12000 MHz.
Admite funcionamiento pulsado.



Valores de la tabla RF: Potencia de salida saturada: 39 dBm (típico); Ganancia de potencia: 18 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 43 % (típico). Condiciones de ensayo RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V. Dimensiones del die: 2.3 × 1.15 × 0.1 mm.

Características RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	f	8000	-	12000	MHz
Potencia de salida saturada	Psat	38	39	-	dBm
Ganancia de potencia	Gp	17	18	-	dB
Planitud de la ganancia de potencia	ΔGp	-	-	±0.7	dB
Eficiencia de potencia añadida	PAE	-	43	-	%
Ganancia de pequeña señal	S21	-	27	29	dB
Planitud de la ganancia de pequeña señal	ΔS21	-	-	±2	dB
VSWR de entrada	VSWR(in)	-	1.6	3	-

Polarización DC y corrientes

TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión de drenador	Vd	-	28	32	V
Tensión de puerta	Vg	-3.4	-2.6	-2.4	V
Corriente de drenador en reposo	Id	-	0.2	-	A
Corriente dinámica de drenador	Idd	-	0.7	0.8	A
Corriente dinámica de puerta	Igg	-	0.2	1	mA

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión drenador-fuente máxima	Vd	-	-	36	V
Polarización de puerta mínima	Vg	-5	-	-	V

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Potencia de entrada máxima	Pin	-	-	28	dBm
Temperatura máxima del canal	Top	-	-	225	°C
Temperatura de almacenamiento	TSTG	-65	-	150	°C

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del die	2.3 × 1.15 × 0.1	mm
Tolerancia del contorno en planta	±100 (Solo contorno en planta; no se especifica la tolerancia del espesor.)	µm

Registro de la publicación actual · 1.7 · 2026-11-12. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.6.

Integración del chip y secuencia de polarización

Al encender, aplicar la polarización de puerta antes que la de drenador. Al apagar, retirar primero la del drenador. Manipular en un entorno limpio con protección ESD y utilizar un soporte con expansión térmica compatible con el die de SiC.

Dimensiones de los pads de conexión

Símbolo: RFin; Dimensiones (µm): 100 × 100. Símbolo: Vg; Dimensiones (µm): 100 × 100. Símbolo: Vd1; Dimensiones (µm): 100 × 100. Símbolo: Vd2; Dimensiones (µm): 100 × 100. Símbolo: RFout; Dimensiones (µm): 100 × 100.

Plano dimensional mecánico

Contorno y coordenadas acotadas en mm. Este plano sirve como referencia dimensional. Para la fabricación y el conexionado por hilo se requieren planos completos.

LCI-PA-8000-12000-PS39T-D



X (mm)
Vg: 0.270
Vd1: 1.024
Vd2: 2.070

Y (mm)
RFin / RFout: 0.510

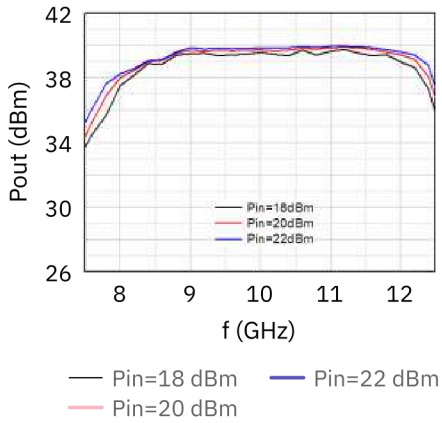
2.300 × 1.150 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

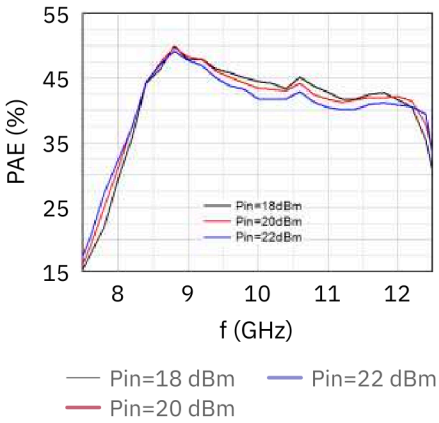
Curvas de rendimiento

Cada gráfica de rendimiento corresponde a las condiciones de funcionamiento que indica.

Potencia de salida; Eficiencia de potencia añadida; Corriente de drenador; Ganancia de pequeña señal; Adaptación de entrada.

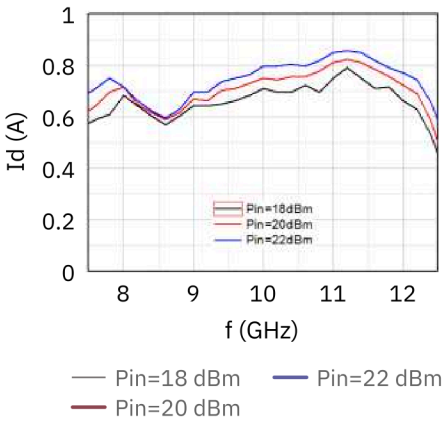
Notas de la figura: Vd=+28V; Vg=-2.6V. (1–3): Pin = 18 / 20 / 22 dBm. Las condiciones corresponden a las subfiguras indicadas y a sus propias leyendas.

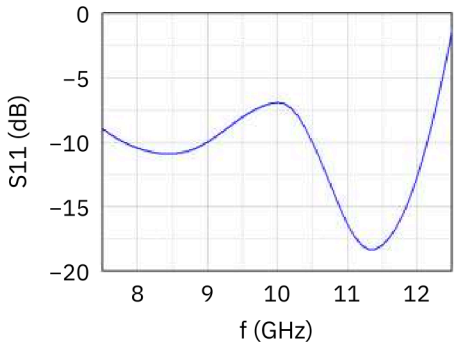




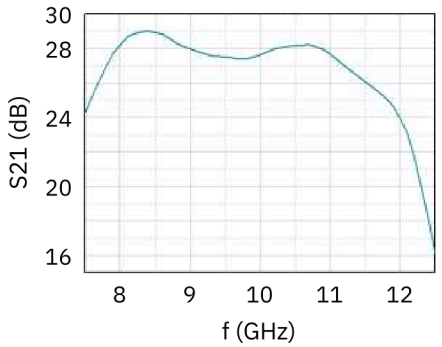
Pin=18 dBm Pin=22 dBm
Pin=20 dBm

Pin=18 dBm Pin=22 dBm
Pin=20 dBm





Pin=18 dBm Pin=22 dBm
Pin=20 dBm



Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.